

## Обзоры

*Захаров А.Ю.*

**Теория электронной структуры полупроводниковых твердых растворов замещения. Аналитические подходы**

**865**

*Ундалов Ю.К., Теруков Е.И.*

**Нанокластеры кремния, ncl-Si, в матрице гидрированного аморфного субоксида кремния, a-SiO<sub>x</sub> : H (0 < x < 2)**

**887**

## Электронные свойства полупроводников

*Аскеров Э.Б., Dang N.T., Бескровный А.И., Мададада А.И., Исмаилов Д.И., Мехдиева Р.Н., Jabarov S.H., Керимова Э.М.*

**Магнитная структура в халькогенидах TlFeS<sub>2</sub> и TlFeSe<sub>2</sub>**

**899**

*Гаджиалиев М.М., Баширов Р.Р., Пирмагомедов З.Ш., Эфендиева Т.Н., Медге Х., Филар К.*

**Термоэдс n-InSb в поперечном квантующем магнитном поле**

**904**

*Козырев С.П.*

**Особенности перколяционной схемы перестройки колебательного спектра сплава с составом для Cd(TeSe) и (CdZn)Te с малой жесткостью связи**

**906**

*Грушка О.Г., Савчук А.И., Чупыра С.Н., Биличук С.В.*

**Поведение примеси железа в кристаллах Hg<sub>3</sub>In<sub>2</sub>Te<sub>6</sub>**

**913**

## Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

*Редько Р.А., Будзуляк С.И., Корбутяк Д.В., Лоцько А.П., Вахняк Н.Д., Демчина Л.А., Калитчук С.М., Конакова Р.В., Миленин В.В., Быков Ю.В., Егоров С.В., Еремеев А.Г.*

**Влияние СВЧ-обработок на люминесцентные свойства монокристаллов CdS и CdTe : Cl**

**916**

*Kumar N. Sadananda, Bangera Kasturi V., Shivakumar G.K.*

**Properties of antimony doped ZnO thin films deposited by spray pyrolysis technique**

**920**

## Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

*Милахин Д.С., Малин Т.В., Мансуров В.Г., Галицин Ю.Г., Журавлев К.С.*

**Нитризация нереконструированной и реконструированной (sqrt(31)sqrt поверхности (0001) сапфира**

**в потоке аммиака**

**925**

## Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

<i>Лаврухин Д.В., Ячменев А.Э., Бугаев А.С., Галиев Г.Б., Климов Е.А., Хабибуллин Р.А., Пономарев Д.С., Мальцев П.П.</i>	
<b>Исследование оптических свойств GaAs, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии при низких температурах роста, с <i>delta</i>-легированными слоями Si</b>	<b><u>932</u></b>
<i>Середин П.В., Леньшин А.С., Голощапов Д.Л., Лукин А.Н., Арсентьев И.Н., Бондарев А.Д., Тарасов И.С.</i>	
<b>Исследования наноразмерных пленок Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, полученных на пористом кремнии методом ионно-плазменного распыления</b>	<b><u>936</u></b>
<i>Кульбачинский В.А., Овешников Л.Н., Лукин Р.А., Юзеева Н.А., Галиев Г.Б., Климов Е.А., Пушкарёв С.С., Мальцев П.П.</i>	
<b>Влияние конструкции буфера и ориентации подложки на подвижности электронов в метаморфных структурах In<sub>0.70</sub>Al<sub>0.30</sub>As/In<sub>0.76</sub>Ga<sub>0.24</sub>As/In<sub>0.70</sub>Al<sub>0.30</sub>As на подложках GaAs</b>	<b><u>942</u></b>
<i>Иванов П.А., Самсонова Т.П., Ильинская Н.Д., Серебренникова О.Ю., Коньков О.И., Потапов А.С.</i>	
<b>Сопrotивление 4H-SiC барьеров Шоттки при высоких плотностях прямого тока</b>	<b><u>951</u></b>
<i>Жуков А.Е., Асрян Л.В., Семенова Е.С., Зубов Ф.И., Крыжановская Н.В., Максимов М.В.</i>	
<b>Оптимизация асимметричных барьерных слоев в лазерных гетероструктурах InAlGaAs/AlGaAs на подложках GaAs</b>	<b><u>956</u></b>
<i>Голобокова Л.С., Настаушев Ю.В., Дульцев Ф.Н., Крыжановская Н.В., Моисеев Э.И., Кожухов А.С., Латышев А.В.</i>	
<b>Оптические и электрофизические свойства кремниевых нанопилларов</b>	<b><u>961</u></b>
<i>Chernev A.L., Bagraev N.T., Klyachkin L.E., Emelyanov A.K., Dubina M.V.</i>	
<b>DNA detection by THz pumping</b>	<b><u>966</u></b>
<b>Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники</b>	
<i>Атаева С.У., Мехтиева С.И., Исаев А.И.</i>	
<b>Дисперсия показателя преломления халькогенидного стеклообразного полупроводника Se<sub>95</sub>Te<sub>5</sub>, легированного самарием</b>	<b><u>971</u></b>
<i>Курочкин Н.С., Ващенко А.А., Витухновский А.Г., Тананаев П.Н.</i>	
<b>Исследование влияния длины пассивирующей квантовые точки лиганда на электрооптические характеристики органических светодиодов</b>	<b><u>975</u></b>
<b>Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники</b>	
	<b><u>981</u></b>

*Александрова Е.Л., Светличный В.М., Матюшина Н.В., Мяжкова Л.А., Дайнеко С.В., Мартынов И.Л., Тамеев А.Р.*

**Люминесцентно-кинетическая спектроскопия сложных комплексов полифенилхинолинов**

*Васильев В.И., Гагис Г.С., Кучинский В.И., Данильченко В.Г.*

**Формирование тройных твердых растворов  $A^{III}B^V$  на пластинах GaAs и GaSb за счет твердофазных реакций замещения**

**984**

## **Физика полупроводниковых приборов**

*Кюрегян А.С.*

**Лавинный режим переключения перенапряженных высоковольтных  $p^+i-n^+$ -диодов в проводящее состояние при импульсном освещении**

**989**

*Павлюченко А.С., Марков Л.К., Смирнова И.П., Закгейм Д.А.*

**Расчет оптимальной конфигурации двухслойной пленки ITO для использования в составе отражающих контактов светодиодов синего и ближнего ультрафиолетового диапазонов**

**994**

*Иванов П.А., Потапов А.С., Самсонова Т.П.*

**Влияние ударной ионизации примесей на динамические характеристики  $p^+n^-$ - $n^+$ -диодов на основе 4H-SiC при низкой температуре (77 К)**

**999**

*Безъязычная Т.В., Богданович М.В., Кабанов В.В., Кабанов Д.М., Лебедок Е.В., Паращук В.В., Рябцев А.Г., Рябцев Г.И., Шпак П.В., Щемелев М.А., Андреев И.А., Куницына Е.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П.*

**Оптоэлектронные пары светодиод-фотодиод на основе гетероструктуры InAs/InAsSb/InAsSbP для детектирования углекислого газа**

**1003**